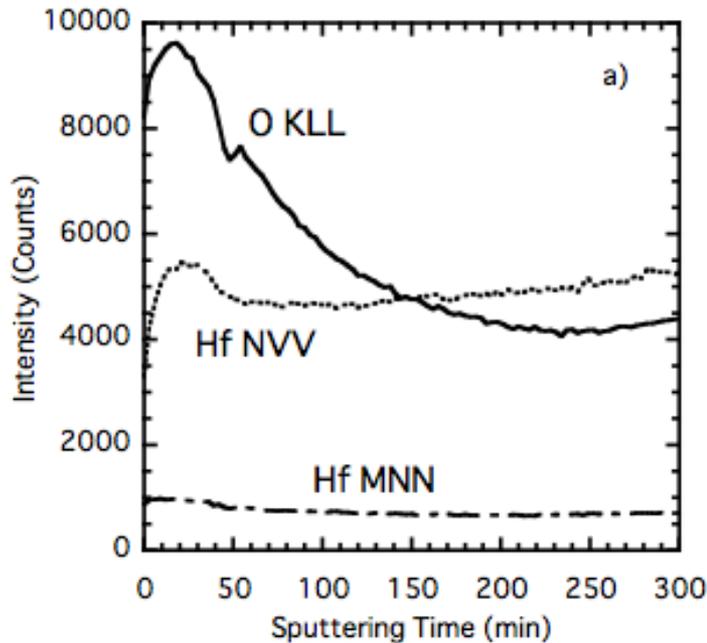
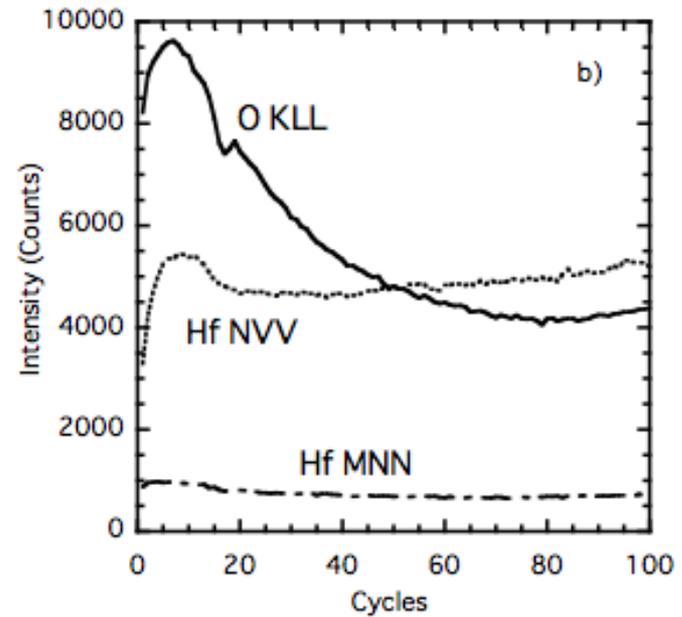


研究論文, ” 極低角度入射ビームオージェ深さ方向分析によるHfO₂/Si基板の分析” に掲載されている Fig.5
オージェデプスプロファイルの Raw data ファイル

DOI <https://doi.org/10.1384/jsa.24.192> 荻原俊弥, 長田貴弘, 吉川英樹, *J. Surf. Anal.* **24**, 192 (2018).



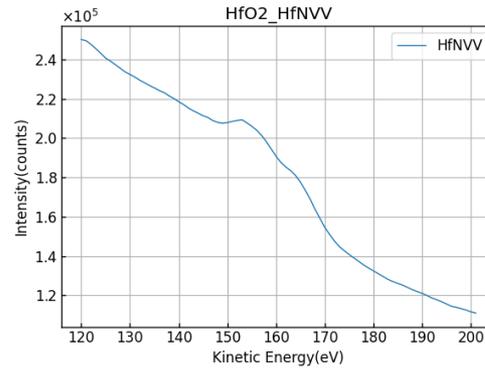
AES depth profiles of the HfO₂:55 nm/Si substrate
using the ultra low angle incident beam method
with the argon ion energy of 0.5 keV.



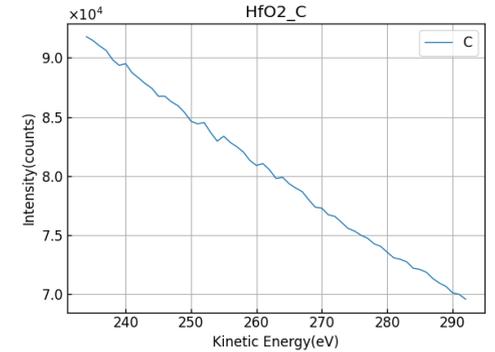
AES depth profiles of the HfO₂:55 nm/Si substrate
using the ultra low angle incident beam method
with the argon ion energy of 0.5 keV.

- a) のオージェデプスプロファイルは論文に掲載の Fig.5 に相当し、横軸は nm である。
b) は横軸を測定回数で表したものであり、横軸を nm に変換する前のプロファイルである。
Raw data ファイルは、b) に対応している。

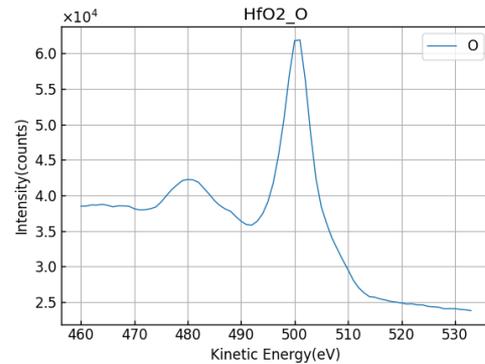
Energy (eV)	Intensity		
120	250190	170	154647
121	249581	171	151012
122	247714	172	147631
123	245537	173	144811
124	243190	174	142736
125	240763	175	140827
126	239163	176	139068
127	237396	177	137258
128	235550	178	135463
129	233735	179	133923
130	232422	180	132476
131	231086	181	130976
132	229505	182	129566
133	228198	183	128109
134	226798	184	127018
135	225597	185	126065
136	224251	186	125200
137	223193	187	124018
138	221563	188	122887
139	220210	189	121924
140	218554	190	121022
141	217131	191	119903
142	215332	192	118676
143	213914	193	117745
144	212708	194	116753
145	211430	195	115618
146	210514	196	114424
147	208977	197	113928
148	208038	198	113250
149	207596	199	112549
150	207915	200	111609
151	208523	201	110976
152	208981		
153	209382		
154	207827		
155	206094		
156	204113		
157	201486		
158	198232		
159	194559		
160	190814		
161	187652		
162	185330		
163	183505		
164	181026		
165	177668		
166	173486		
167	169009		
168	163832		
169	159212		



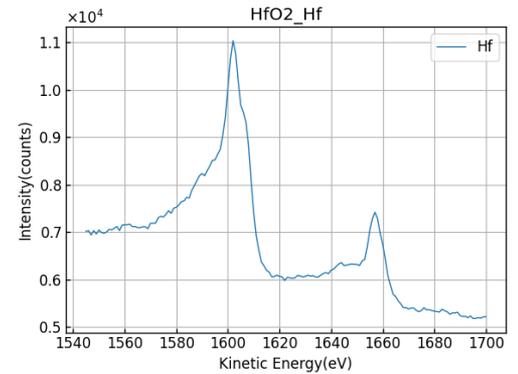
Raw data of Hf-NVV



Raw data of C



Raw data of O



Raw data of Hf

Raw data の図化

Hf-NVV Raw data ファイルの構造